

2SA1221, 1222

PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

PNP Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

特長/FEATURES

- TVの垂直偏向出力、音声出力および各種電源など高耐圧大電流用途に最適です。
- 2SC2958, 2SC2959とコンプリメンタリで使用できます。

$$V_{CEO}=140\text{ V}\cdots 2SA1221/2SC2958$$

$$V_{CEO}=160\text{ V}\cdots 2SA1222/2SC2959$$

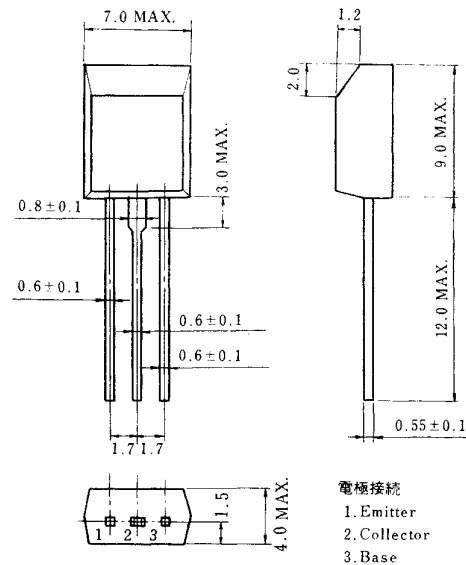
絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-160	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-140/-160	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-500	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-1.0	A
全損失	P_T	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

*PW \leq 10 ms, Duty Cycle \leq 50 %

外形図/PACKAGE DIMENSIONS

(Unit: mm)



電極接続
1. Emitter
2. Collector
3. Base

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-100\text{ V}, I_E=0$			-200	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5.0\text{ V}, I_C=0$			-200	nA
直流電流増幅率	h_{FE} **	$V_{CE}=-2.0\text{ V}, I_C=-100\text{ mA}$	100	150	400	
直流ベース電圧	V_{BE} **	$V_{CE}=-5.0\text{ V}, I_C=-20\text{ mA}$	-0.6	-0.64	-0.7	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C=-1.0\text{ A}, I_B=-0.2\text{ A}$		-0.6	-0.9	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ **	$I_C=-1.0\text{ A}, I_B=-0.2\text{ A}$		-1.1	-1.3	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{ V}, I_E=0, f=1.0\text{ MHz}$		24	40	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=-10\text{ V}, I_E=20\text{ mA}$	30	45		MHz

**ハルス測定 PW \leq 350 μ s, Duty Cycle \leq 2 %, Pulsed

h_{FE} 規格区分

捺印	M	L	K
h_{FE}	100~200	160~320	200~400

特線曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

